第13卷 第4期

加宽以及猝灭速率的影响部。但是,在双道

至去4m, 由热引起的新给编度引起光束

表面多结 MOMOM 产生相干电磁振荡

廖世强 王玉珠

(中国科学院上海光机所)

提要:提出并研制了一种集成式表面多结 MOMOM(金属-氧 化层-金属-氧 化层-金属),并在低频波段观察到了相干电磁振荡。

Generation of electro-magnetic oscillation in surface multi-junction MOMOM

Liao Shiqiang, Wang Yuzhu

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

Abstract; An integrated surface multi-junction MOMOM (metal-oxide-metal-oxide-metal) is reported and coherent electro-magnetic oscillation is observed in the low frequency range.

生射的光東角漂彩 细与不同 (K/Ha Ar/Mi关系

研究红外和远红外区连续可调谐的激光器是一个正在开拓的领域。作为一种途径,Javan^[11] 提出了利用 MOM 产生远红外辐射的建议,他在 W-Ni 点接触式 MOM 上用 CO₂ 激光和微波谐波混频,获得了远红外辐射。 Evenson^[23] 指出了点接触 MOM 最大的优点是有极快的响应时间(τ=10⁻¹⁴~10⁻¹⁵s),预示着有可能在光频波段内用 MOM 获得振荡,Gustafson 研制了一种夹层式 MOM^[3,43],他指出利用这种 MOM 基元有 可能 在宽频段内制成可调谐放大器 和振荡器。最近,Aleksanyan^[53] 报道了用 双夹层式 MOM 在 300 kHz 上观察到了微弱的电磁振荡。

我们提出并研制了一种集成式表面多结

MOMOM 结构^[6]。采用了一种特殊的电形成技术,将金属小岛中的金属离子注入氧化层中,使得 MOM 结之间产生弱耦合。 另外,MOMOM 器件有很大的作用区,能对激光产生快响应。 特别是还观察 到了 MOMOM 在偏压作用下的发光现象。根据这种实验规律建立了 MOMOM 的振荡模型,同时在低频段观察到了相干电磁振荡讯号。

二、表面多结 MOMOM 振荡模型

在实验中观察到的现象只是当表面 MOMOM 经过电形成效应以才后会出现^[33], 也就是说 MOM 结的两个金属小岛之间存在 有一种弱耦合条件。当一个偏置的表面多结

收稿日期: 1985年1月31日。

MOMOM 处在外辐射场中时,这时至少发生两种过程:一种是电子在偏压作用下从MOM结的一个金属小岛穿透势垒到达第二个金属小岛,同时伴随发射一个光量子,图1是这种机理的示意图。另一种过程是在外场作用下,金属小岛中的电子吸收一个光量子后,光助发射穿过势垒,产生快响应^[4]。这两种过程的结合,使得 MOMOM 在偏置作用下,在外辐射场中类似于一个两能级系统。

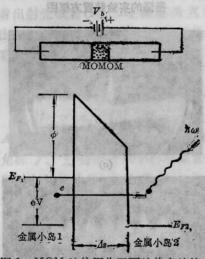


图 1 MOM 结偏压作用下的势垒结构, 以及电子的隧道穿透及辐射光子示意图

下面要讨论的是在一个稳态振荡的谐振 腔内,这两种过程的结合可能产生的物理现 象。

如果将每一对相邻的金属小岛都看成是一个 MOM 结。电形成效应使得这对金属小岛之间有一个弱耦合。假设多结 MOMOM 是均匀分布,而且有相同的全宽 4%。这样只需要描述一个单结,再推广到多结的串接和并联情形就可以了。在单结 MOM 中,势垒一边的电子通过弱耦合,能与势垒另一边的电子相互作用。这时金属小岛中描述电子的量子态函数可以写为.

$$\psi = \sqrt{\rho} e^{-i\theta} \, , \tag{1}$$

 ρ 为电子密度, θ 为描述电子的位相函数,

$$\theta = \frac{E}{\hbar} t + \varphi(t)$$

$$\frac{\partial \psi_1}{\partial t} = \frac{-i}{\hbar} \left[E_1 \psi_1 + K_2 \psi_2 \right] , \qquad (2)$$

K 为描述电形成效应引起的两个金属 小岛之间的耦合量, $K\ll 1$ 。

另外,由(1)式有

$$\frac{\partial \psi_{1}}{\partial t} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\rho}} \cdot \frac{d\rho}{dt} e^{-i\theta_{1}}$$

$$-i \left(\frac{E_{1}}{\hbar} + \dot{\varphi}_{1}\right) \sqrt{\rho} e^{-i\theta_{1}}, \qquad (3)$$

由于式(2)和式(3)是相等效的,即

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\rho}} \cdot \frac{d\rho}{dt} e^{-i\theta_1}$$

$$-i\left(\frac{E_1}{\hbar} + \dot{\varphi}_1\right) \sqrt{\rho} e^{-i\theta_1}$$

$$= \frac{-iE_1}{\hbar} \sqrt{\rho} e^{-i\theta_1} - \frac{ik}{\hbar} \sqrt{\rho} e^{-i\theta_2} \diamond$$
(4)

取实部, 并且 $\frac{d\rho}{dt} = I$, 有 $I = \frac{2K}{\hbar} \rho \sin \left[\frac{1}{\hbar} (E_1 - E_2) t + (\varphi_1 - \varphi_2) \right]_{\circ}$ (5)

则电流密度为

$$J = J_0 \sin\left[\frac{E_1 - E_2}{\hbar} t + \varphi_0\right] \qquad (6)$$

式中 $\varphi_0 = \varphi_1 - \varphi_2$, $J_0 = \frac{2K\rho}{\hbar\Delta\alpha}$, $\Delta\alpha$ 为势全截面积。

当存在偏压时,
$$E_1-E_2=\mathrm{eV}$$
. 则
$$J=J_0\sin\left(\frac{\mathrm{eV}}{\hbar}t+\varphi_0\right)_{\circ} \tag{7}$$

式中, $e/\hbar = 241.8 \,\mathrm{MHz}/\mu\mathrm{V}_{\circ}$

式(7)表示了电子穿透势垒时伴随产生辐射,辐射频率为,

$$f = \frac{\partial}{\partial t} (\theta_1 - \theta_2) = \frac{\mathrm{eV}}{\hbar} \, (8)$$

上述推导的结论是辐射频率与垒宽及结上的偏压降有关,实验中已观察到了MOMOM的可见光发射。从(7)式可以推断从红外到远红外,以及更低频段的电磁辐射同样存在,只要选择适当的垒宽及偏压就行。

实际情形是在制作多结 MOMOM 时,各单结的势垒宽 4s 并不一致。当许多 MOM 结串接和并联在一起时,在偏压作用下各个单结上的偏压降是各不相同的。因此,MOMOM 发的并不是均匀的单色光,而是各色光点的随机分布。

将表面 MOMOM 放置在谐振腔中,谐振腔中辐射的电场强度 $\varepsilon(\mathbf{r},t)$ 满足波动方程,

$$\nabla^2 \mathbf{\varepsilon} = \frac{1}{c^2} \, \dot{\mathbf{\varepsilon}} + \frac{4\pi}{c^2} \, \dot{\mathbf{\varepsilon}} + \frac{4\pi}{c^2} \, \sigma \dot{\mathbf{\varepsilon}}_{\circ} \qquad (9)$$

代入式(7),很容易得到振荡条件。<见附录>

$$\begin{cases} \dot{\varphi}E_n = 0, \\ \frac{J_{n0}}{E_n} = \frac{-1}{4\pi Q_n} = \frac{-\sigma}{\omega_n} \end{cases}$$
 (10)

式中 E_n 是谐振腔内驻波场的振幅; φ 是驻波场的位相; J_{n0} 是谐振时, MOMOM中电子穿透势全时产生与腔谐振频率相同的辐射场强度。

(10)式与激光器的工作条件相类似,物理意义是很明显的。由于表面多结 MOMOM 在谐振腔内的电磁辐射,以及 MOMOM 对腔内共振场的响应,在腔内形成了稳态共振,振荡增益正好抵消了各种耗损机制所引起的振幅衰减。而振荡的建立正是以 MOMOM 对外辐射场的响应为条件,逐步建立。因此,原则上可以发展一种频段很宽可调谐的多结MOMOM 振荡器或放大器。

三、实验

我们在低频端观察到了表面多结 MOMOM 的相干振荡输出。观察讯号的实验方框图见图 2。实验中多结 MOMOM 放置在真空室中,真空度保持在 $10^{-2} \sim 10^{-5}$ Torr。使用的 MOMOM 的窗口宽度大于 1 mm,谐振回路在 $8 \sim 22$ MHz 内可调。用频谱仪和示波器同时监测振荡情况。当偏压调到适当数值时,从示波器可以观察到振荡输出波形。值得注意的是在整个 $I \sim V$ 特征曲线上,都能产生振荡,最大振荡讯号出现在偏压进入

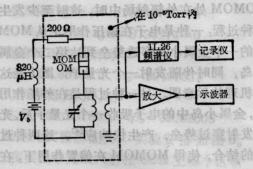
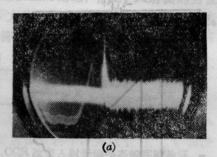


图 2 观察 Ag-Al₂O₃-Ni-Al₂O₃-Ag 产生 振荡的实验装置方框图



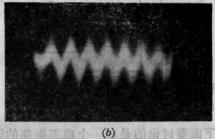


图 2 Ag-Al₂O₃-Ni-Al₂O₃-Ag 的振荡输出

- (a) 从 IL26 频谱仪输出的 22 MHz 频谱;
- (b) 8 MHz 讯号直接放大后的波形

负阻区以前。

图 3 是振荡输出的监测照片,讯号的峰值为 0.4 mV,振荡功率不大于 2×10⁻⁷ W,激励电子非弹性穿透势垒的 功率为 0.1 W,转换效率仅为 2×10⁻⁶。照片上波形的讯号噪声比很差,原因是在制备表面多结 MOMOM 的实际操作过程中,各个单结 MOM 中的势垒垒宽 4s 并不相同,有很大离散。另一个原因是电形成效应不可能对所有单结 MOM 都是均匀一致的。这样,当在两个电极上加上一定的偏压时,各个单结上的偏压降各不相同,在 MOMOM 中电子穿透多个势垒时伴生

的电磁辐射就有极宽的频带,形成了量子噪声背景。实际上,真正对产生相干振荡有贡献的只是 MOMOM 中全部单结 MOM 总数中的极小一部份,因而转换效率很低。从(10)式可知,本实验中的 MOMOM 用于观察红外及远红外区的相干电磁振荡时,从技术工艺上讲是极其困难的。作者认为,经过技术工艺上讲是极其困难的。作者认为,经过技术工艺上的努力,在制备表面多结 MOMOM 时,寻找一种严格的规格化的工艺技术,使得各个单结 MOM 都有相同的势垒垒宽,以及十分均匀的电形成过程。观察 到 MOMOM 在更短波长上的振荡,将是有可能的。

附 录

当表面多结 MOMOM 置于谐振腔中时,谐振腔中的辐射电场强度 $\varepsilon(r,e)$ 满足波动方程:

$$\nabla^2 \mathbf{\varepsilon} = \frac{1}{c^2} \ddot{\mathbf{\varepsilon}} + \frac{4\pi}{c^2} \ddot{\mathbf{J}} + \frac{4\pi}{c^2} \sigma \dot{\mathbf{\varepsilon}}, \qquad (\mathbf{A} \cdot \mathbf{1})$$

如果腔内的振荡波场为单一的线偏振波场,并且所 讨论的振荡波场限于谐振腔内较低次的横向共振模 场,可以认为波场主要沿 z 轴变化,则矢量波动方程 简化为标量波动方程,

$$\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial y^2} - \frac{4\pi}{c^2} \sigma \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} - \frac{1}{c} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = \frac{4\pi}{c^2} \frac{\partial^2 J}{\partial t^2}.$$
(A 2)

式中,左边第二项为衰减项,表示光子寿命,右边与 多结 MOMOM 的穿透电流密度有关,为振荡的激励 源。

共振时第 n 个轴模驻波数为。

$$K_n = 2\pi/\lambda_n = n\pi/L$$
, **L** 为腔长。

驻波场为

$$\varepsilon_n(z,t) = A_n(t)\sin K_n z$$

$$= E_n(t)\cos(\omega_n t + \varphi)\sin K_n z$$

式中 $\omega_n = CK_n$,振幅 $E_n(t)$ 和位相 $\varphi(t)$ 都是以 $1/\omega_n$ 为刻度缓慢变化的函数。 腔内电场 $\varepsilon(s,t)$ 为全部驻 波场的迭加, 即

$$\varepsilon(z,t) = \sum_{n} \varepsilon_{n}(z,t) = \sum_{n} A_{n}(t) \sin K_{n}z$$
$$= \sum_{n} E_{n}(t) \cos(\omega_{n}t + \varphi) \sin K_{n}z_{o} \quad (A \cdot 3)$$

将($A \cdot 3$)代入($A \cdot 2$),两边乘以 $\sin K_n s$ 。对腔的全部空间积分。注意到正弦函数的正交性,同时比较等号左右两边正弦和余弦函数的系数后,有

$$\dot{E}_n + \frac{\omega_n}{Q_n} \dot{E}_n + \left[\omega_n^2 - (\omega_n + \dot{\phi})^2\right] E_n = 0_o$$
(A·4)

$$\begin{split} & \left[2(\omega + \dot{\varphi})_n \dot{E} + \ddot{\varphi} + \frac{\omega_n}{Q_n} (\omega_n + \dot{\varphi}) \right] E_n \sin(\omega_n t + \varphi) \\ &= -4\pi \left(\frac{eV}{\hbar} + \dot{\varphi} \right)^2 J_{no} \sin\left(\frac{eV}{\hbar} t + \varphi_0 \right)_o \quad (A \cdot 5) \end{split}$$
其中,
$$Q_n = \omega_n / 2\pi \sigma,$$

$$J_{no} = \frac{2}{L} \int_{0}^{L} J_{o} \sin K_{n} z dz_{o}$$

在稳态共振时,必须满足

$$\frac{eV}{\hbar} = \omega_n, \quad \varphi_0 = \varphi, \quad \not E = 0_o$$

同时在上式中忽略掉小量 öE, 这时有振荡条件

$$\begin{cases} \dot{\varphi}E_n = 0_o \\ \frac{J_{no}}{E_n} = \frac{-1}{4\pi Q_n} = \frac{-\sigma}{\omega_n} \end{cases}$$
 (A·6)

参考文献

- [1] A. Sanchez et al.; Appl. Phys.Lett., 1972,21, No. 5, 240.
- [2] K.M.Evenson et al.; Appl. Phys. Lett., 1973, 22,
- [3] T.K. Gustafson et al.; Appl. Phys. Lett., 1970, 24, 620.
- [4] M. Heiblum et al.; IEEE J. Quant. Electr., 1978, QE-14, 159.
- [5] A. G. Aleksanyan et al.; Sov. J. Quant. Electr., 1982, 12, 1090.
- [6] 廖世强; 《中国激光》, 1985, 12, No. 3, 152.

. 215 .